

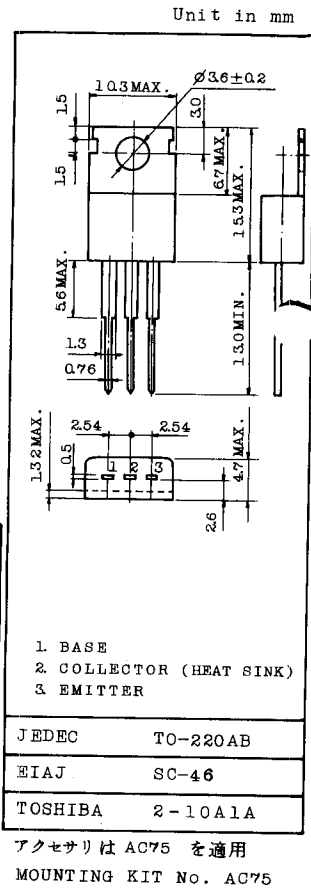
2SA816

シリコンPNPエピタキシャル形トランジスタ(PCT方式)
SILICON PNP EPITAXIAL TRANSISTOR (PCT PROCESS)

- 中電力増幅用
- 励振段増幅用
- Medium Power Amplifier Applications
- Driver Stage Amplifier Applications
- 高耐圧です: $V_{CEO} = -80V$
- 高出力 Hi-Fi Amp の励振段に適します。
- 2SC1626 とコンプリメンタリになります。
- Complementary to 2SC1626

最大定格 MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ C$)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	-80	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-80	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	-5	V
コレクタ電流	I_C	-750	mA
エミッタ電流	I_E	750	mA
コレクタ損失	P_C	1.5	W
接合温度	T_j	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-55~150	$^\circ C$



* PCT 技術により製造されています。

Produced by Perfect Crystal Device Technology.

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -30\text{V}, I_E = 0$	-	-	-0.5	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -5\text{V}, I_C = 0$	-	-	-1.0	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = -10\text{mA}, I_B = 0$	80	-	-	V
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E = -0.1\text{mA}, I_C = 0$	5	-	-	V
電流増幅率	$h_{FE(1)}$ (Note)	$V_{CE} = -2\text{V}, I_C = -150\text{mA}$	70	-	240	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE} = -2\text{V}, I_C = -500\text{mA}$	40	-	-	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -500\text{mA}, I_B = -50\text{mA}$	-	-	-0.5	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE} = -2\text{V}, I_C = -500\text{mA}$	-	-	-1.0	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE} = -2\text{V}, I_C = -150\text{mA}$	50	100	-	MHZ
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = -10\text{V}, I_E = 0$ $f = 1\text{MHz}$	-	20	-	pF

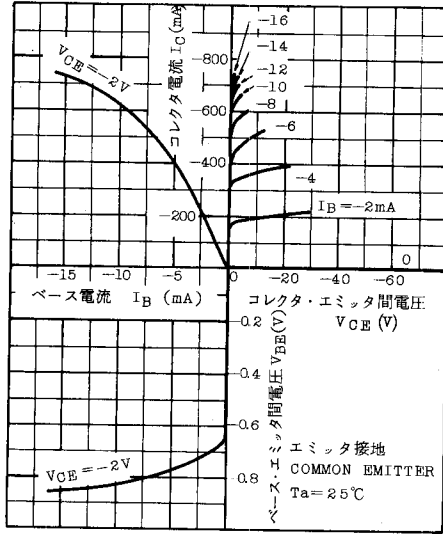
Note : $h_{FE(1)}$ により下表のように分類し、現品表示してあります。

According to the value of $h_{FE(1)}$, the 2SA816 is classified as follows.

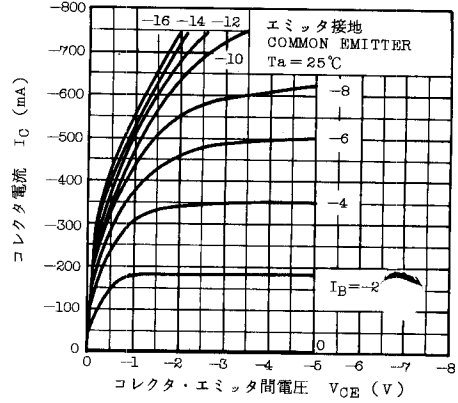
CLASSIFICATION	MIN.	MAX.
2SA816-0	70	140
2SA816-Y	120	240

2SA816

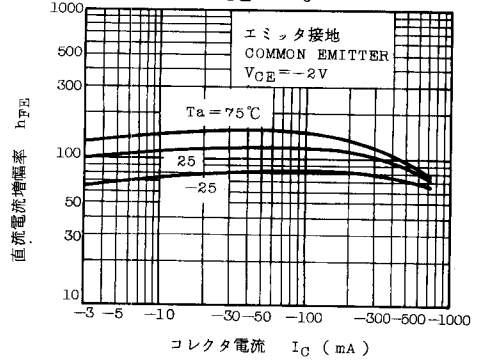
STATIC CHARACTERISTICS



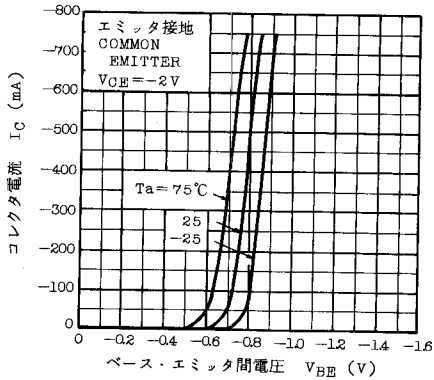
$I_C - V_{CE}$ (LOW VOLTAGE REGION)



$h_{FE} - I_C$



$I_C - V_{BE}$



$V_{CE(sat)} - I_C$

